Analyse structurale par diffraction x monocristal

Sébastien Pillet

Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations Université de Lorraine







Ecole « cristallographie et grands équipements », SOLEIL, 13-17 octobre 2014

Un cristal





Relation structure/propriétés









modèle

structural



DRX

- 1. Mesure de diffraction
- 2. Indexer les réflexions de Bragg
- 3. Intégrer les réflexions
- 4. Réaliser des corrections
 - (absorption, polarisation, ...)
- 5. Réduire les données







6. Déterminer7. Affiner la structure cristalline



 $\left\{ \vec{H}, I(\vec{H}), \sigma(I(\vec{H})) \right\}$









8. Exploitation Paramètres physiques + déviation standard



Symétrie Distances de liaison Angles de liaison Désordre Agitation thermique

à l'équilibre thermodynamique ou hors équilibre



, $I(\vec{H})$, $\sigma(I(\vec{H}$



Principe de la diffraction x monocristal



Diffusion élastique Thomson Processus radial

 $\lambda \left[\mathring{A} \right] = \frac{12.398}{\varepsilon \left[\text{keV} \right]} \qquad k_i = k_d \left(\lambda_i = \lambda_d \right)$

Diffraction

(interférences constructives entre les ondes diffusées par tous les électrons du matériau)



système périodique

Le facteur de structure de la maille





Le facteur de structure et la fonction d'interférence



Fonction d'interférence



Présente des extrema pour des valeurs entières de h, k, l

Effet de taille finie

Effet de taille finie sur le processus de diffraction :

$$\rho_{cristal}(\vec{r}) = \rho_{cristal\infty}(\vec{r}) \cdot [\text{boite}(\vec{r})] = \left[\sum_{u,v,w=-\infty}^{+\infty} \delta(\vec{r} - \vec{r}_{u,v,w})\right] * \left[\sum_{maille} \rho_{atomique}(\vec{r})\right] \cdot [\text{boite}(\vec{r})]$$

$$\mathbf{TF} \int_{F_{cristal}} (\vec{H}) = \Gamma(\vec{H}) \cdot F_{maille}(\vec{H}) * B(\vec{H})$$

$$B(\vec{H}) = \frac{\sin(\pi L_a q_x)}{\pi q_x} \frac{\sin(\pi L_b q_y)}{\pi q_y} \frac{\sin(\pi L_c q_z)}{\pi q_z} \frac{500}{400}$$

$$(\vec{y}) = \frac{300}{-200} \frac{100}{-200} \frac{100}{$$

Réseau réciproque associé à un monocristal



Principe d'une mesure de diffraction x monocristal



Position des pics = Paramètres de maille Intensité des pics = Contenu de la maille Forme des pics = Microstructure







Géométrie de la diffraction, condition de Bragg



Géométrie de la diffraction, condition de Bragg



Condition de Bragg : la différence de chemin entre les 2 ondes doit être un nombre entier de fois la longueur d'onde pour obtenir des interférences constructives









Enregistrement d'images de diffraction



animation

Enregistrement d'images de diffraction







Indexation et intégration des données

Indexer : déterminer la matrice d'orientation et les paramètres de maille a*, b*, c*, α *, β *, γ * tels que les indices de Miller h,k,l qui définissent la position de chaque pic de Bragg dans l'espace réciproque soient entiers : $\vec{H} = h\vec{a}$ *+ $k\vec{b}$ *+ $l\vec{c}$ *





Réduction de données

1) Corrections

- correction de Lorentz
- correction de polarisation
- correction d'absorption

$$I(\vec{H}) = \lambda^3 r_e^2 \left(\frac{V_{cristal}}{V_{maille}^2}\right) LPA(\vec{H}) F(\vec{H})^2$$

Réduction de données

1) Corrections

- correction de Lorentz
- correction de polarisation
- correction d'absorption

$$I(\vec{H}) = \lambda^3 r_e^2 \left(\frac{V_{cristal}}{V_{maille}^2}\right) LPA(\vec{H}) F(\vec{H})^2$$

$$L = \frac{1}{\sin 2\theta}$$

$$P = \cos^2 2\theta$$

Faisceau polarisé linéairement (synchrotron)

animation

$$P = \frac{1}{2} \left(1 + \cos^2 2\theta \right)$$

Faisceau non polarisé

Facteur de Polarisation



Klug & Alexander, « x-ray diffraction procedures »

$$I = I_{\sigma} + I_{\pi} \propto E_{\sigma}^{2} + E_{\pi}^{2} \propto \left(\sqrt{2}/2\right)^{2} + \left(\sqrt{2}/2\right)^{2} \cos^{2}(2\theta)$$
$$I \propto \frac{1}{2} \left(1 + \cos^{2}(2\theta)\right)$$

Correction d'absorption

$$I = I_0 \exp(-\mu T) \qquad \qquad I(\vec{H}) = \lambda^3 r_e^2 \left(\frac{V_{cristal}}{V_{maille}^2}\right) LPA(\vec{H}) F(\vec{H})^2$$



Réduction de données





Réduction de données



Traitement statistique des réflexions mesurées *n* fois

En cas de forte redondance, on peut effectuer un traitement statistique des informations :

- 1) Rejection des réflexions fortement discordantes ~ travailler sur la zone centrale de la distribution
- 2) Pondération des réflexions fortement discordantes



Détermination de <I>

$$\langle I \rangle = \sum_{i=1}^{n} w_i I_i / \sum_{i=1}^{n} w_i$$

Détermination de $\sigma(\langle I \rangle)$

- la déviation standard de la distribution (RMSD)

$$\sigma_{\rm int}(I) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (I_i - \langle I \rangle)^2}$$

- la déviation standard sur la moyenne (ESD)

 $\sigma(\langle I \rangle) = \sigma_{\rm int}(I) / \sqrt{n}$

Réduction de données

1) Corrections

- correction de Lorentz
- correction de polarisation
- correction d'absorption

$$I(\vec{H}) = \lambda^3 r_e^2 \left(\frac{V_{cristal}}{V_{maille}^2}\right) LPA(\vec{H}) F(\vec{H})^2$$

2) Moyenne et estimation de |F(hkl)| à partir de I(hkl)

$$I_{corrigé}(hkl) = |F(hkl)|^2$$
 $|F(hkl)| = \sqrt{I_{corrigé}(hkl)}$

Réduction de données

1) Corrections

- correction de Lorentz
- correction de polarisation
- correction d'absorption

$$I(\vec{H}) = \lambda^3 r_e^2 \left(\frac{V_{cristal}}{V_{maille}^2}\right) LPA(\vec{H}) F(\vec{H})^2$$

2) Moyenne et estimation de |F(hkl)| à partir de I(hkl)

$$I_{corrigé}(hkl) = |F(hkl)|^2$$
 $|F(hkl)| = \sqrt{I_{corrigé}(hkl)}$

3) Estimation de la déviation standard $\sigma(|F|)$

$$\sigma(|F|) = \frac{1}{2|F|}\sigma(I)$$



5. Déterminer6. Affiner la structure cristalline







 $\left\{ \vec{H}, \left| F(\vec{H}) \right|, \sigma\left(F(\vec{H}) \right) \right\}$

 $\left\{ \vec{H}, I(\vec{H}), \sigma(I(\vec{H})) \right\}$

Méthodes de résolution de structure cristalline

Objectif : déterminer la distribution de densité électronique atomique dans la maille cristalline à partir des données de diffraction

$$F_{maille}(\vec{H}) = TF(\rho(\vec{r}))$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$\rho(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{h,k,l=-\infty}^{+\infty} F(\vec{H}) \exp\left[-2i\pi\vec{H}.\vec{r}\right]$$
avec $F(\vec{H}) = \left|F(\vec{H})\right| \exp\left[i\varphi(\vec{H})\right]$

Problème fondamental = perte de la phase

$$I\left(\vec{H}\right) \propto F\left(\vec{H}\right) \bullet F^*\left(\vec{H}\right) \propto \left|F\left(\vec{H}\right)\right|^2$$



Méthodes de résolution de structure cristalline



edited by Charles W. Carter, Jr., and Robert M. Sweet, pp. 110-128. New York: Academic Press.

R. Blessing, HWI, Buffalo

Méthodes de résolution de structure cristalline

• Méthode du remplacement moléculaire :

- connaissance à priori de fragments moléculaires

• Méthode de l'atome lourd / Patterson : Dirdif, Shelx

- connaissance à priori = structure contient un ou plusieurs éléments de fort poids atomique. Utilise l'effet de contraste

• Méthodes directes : Shelx, Sir

- connaissance à priori = structure cristalline est composé d'atomes discrets : accumulation de densité électronique en certaines régions de l'espace (atomicité), composition chimique, symétrie

• Charge flipping : Superflip

- connaissance à priori = structure cristalline est composé d'atomes discrets : accumulation de densité électronique en certaines régions de l'espace (atomicité)

Méthodes directes

Détermination directe des phases des facteurs de structure à partir des modules des facteurs de structures en utilisant des relations mathématiques et probabilistes

• **positivité** de la densité électronique $\rho(\mathbf{r}) > 0$ (Hauptman & Karle, 1953) : apporte une restreinte sur les sets de phase physiquement acceptables (Déterminant de Hauptman ≥ 0)

- atomicité de la densité électronique (Sayre, 1951)
- symétrie de la structure cristalline (origine)
- composition chimique de la maille cristalline

Facteur de structure normalisé :
$$E(\vec{H}) = \sum_{j=1}^{Nat} \frac{f_j}{\sqrt{\sum f_j^2}} \exp\left[2i\pi \vec{H}.\vec{r}_j\right] = \frac{F(\vec{H})}{\sqrt{\langle F^2(\vec{H}) \rangle_{tranche}}}$$

permet de s'affranchir de l'agitation thermique, et de considérer des atomes ponctuels

P(E) permet de distinguer une structure centrosymétrique d'une structure non centrosymétrique
Méthodes directes : équation de Sayre



Pour des valeurs élevées de $|F(\vec{H})|$, $|F(\vec{H})|^2$ est aussi élevée, réel et positif. Donc il est fort probable que les termes les plus importants de la somme de Fourier soient aussi réels et positifs.

Donc si $F(\vec{K})$ et $F(\vec{H} - \vec{K})$ ont également des modules élevés,

 $\varphi \left(-\vec{H} \right) + \varphi \left(\vec{K} \right) + \varphi \left(\vec{H} - \vec{K} \right) \approx 0$

$$P\left(\varphi(-\vec{H})\middle|\varphi(\vec{K}),\varphi(\vec{H}-\vec{K})
ight)$$

Méthodes directes : formule de la tangente

Si on réécrit l'équation de Sayre
$$F(\vec{H}) = \frac{\gamma(\vec{H})}{V} \sum_{\vec{K}} F(\vec{K}) F(\vec{H} - \vec{K})$$

$$|F(\vec{H})|\exp[i\varphi(\vec{H})] = \frac{\gamma(\vec{H})}{V} \sum_{\vec{K}} |F(\vec{K})F(\vec{H}-\vec{K})|\exp[i(\varphi(\vec{K})+\varphi(\vec{H}-\vec{K}))]$$

 $|F(\vec{H})|\exp[i\varphi(\vec{H})] = A(\vec{H}) + iB(\vec{H})$

$$A(\vec{H}) = \frac{\gamma(\vec{H})}{V} \sum_{\vec{K}} \left| F(\vec{K}) F(\vec{H} - \vec{K}) \right| \cos\left(\varphi(\vec{K}) + \varphi(\vec{H} - \vec{K})\right)$$

$$B(\vec{H}) = \frac{\gamma(\vec{H})}{V} \sum_{\vec{K}} \left| F(\vec{K}) F(\vec{H} - \vec{K}) \right| \sin\left(\varphi(\vec{K}) + \varphi(\vec{H} - \vec{K})\right)$$

Formule de la tangente

$$\tan \varphi(\vec{H}) = \frac{\sum_{\vec{K}} \left| F(\vec{K}) F(\vec{H} - \vec{K}) \right| \sin \left(\varphi(\vec{K}) + \varphi(\vec{H} - \vec{K}) \right)}{\sum_{\vec{K}} \left| F(\vec{K}) F(\vec{H} - \vec{K}) \right| \cos \left(\varphi(\vec{K}) + \varphi(\vec{H} - \vec{K}) \right)}$$

Méthodes directes : formule de la tangente

Formule de la tangente

$$\tan \varphi \left(\vec{H} \right) = \frac{\sum_{\vec{K}} \left| F\left(\vec{K} \right) F\left(\vec{H} - \vec{K} \right) \sin \left(\varphi \left(\vec{K} \right) + \varphi \left(\vec{H} - \vec{K} \right) \right)}{\sum_{\vec{K}} \left| F\left(\vec{K} \right) F\left(\vec{H} - \vec{K} \right) \cos \left(\varphi \left(\vec{K} \right) + \varphi \left(\vec{H} - \vec{K} \right) \right)} \right|$$

Permet d'explorer l'espace des phases en corrélant des phases largement distribuées : méthode itérative d'affinement et d'extension des phases



- Phases affinées dans l'espace réciproque
- Espace réel impose une forte contrainte d'atomicité sur les phases

Méthode de charge flipping (2004)

Algorithme de détermination de structure cristalline ab-initio (structures périodiques et apériodiques, diffraction monocristal et poudre, diffraction x et N)

Méthode itérative dans l'espace dual initialement développée pour la reconstruction d'objet en imagerie (optique) (algorithme Fienup)



- travaille sur une grille 3D de densité électronique

- la très grande majorité des pixels correspond à une valeur faible de densité électronique

Séquence de l'algorithme

1) initialisation avec des phases aléatoires { ϕ (**h**)} 2) calcul de ρ (**r**) par FFT¹ de F(**h**)=F_{obs}(**h**)exp[i ϕ (**h**)] 3) inversion de la densité sur les pixels tels que $\rho < \delta$ 4) calcul de G(**h**) par FFT de la nouvelle densité g(**r**) 5) calcul de F(**h**) à partir de F_{obs}(**h**) et des phases de G(**h**)

6) calcul de $\rho(\mathbf{r})$ par FFT¹ de F(\mathbf{h})

Méthode de charge flipping (2004)





1) Interprétation de la carte 3D de densité électronique
 2) Compléter la structure

Avantage de la méthode : ne fait pas usage des symétries

- pseudo-symétrie
- désordre structurale
- structures apériodiques

Implémentée dans : Platon, Crystals, Jana, superflip

Amélioration (affinement) de la structure cristalline

Observables $\{F_{obs}(\vec{H})|, \sigma(F_{obs}(\vec{H})|)\}$

Affinement moindres carrés ou maximum de vraisemblance ou « steepest descent »

$\begin{cases} F_{calc}(\vec{H}), \varphi_{calc}(\vec{H}) \end{cases}$ $\chi^{2} = \sum_{\vec{H}} \left[\frac{F_{obs} - F_{calc}(\{p_{j}\})}{\sigma(F_{obs})} \right]^{2}$ $\min \chi^{2} \implies \frac{\partial \chi^{2}}{\partial p_{j}} = -2 \sum_{\vec{H}} \frac{F_{obs} - F_{calc}}{\sigma^{2}(F_{obs})} \frac{\partial F_{calc}}{\partial p_{j}} = 0, \quad j = 1, 2, ..., m$

$$F_{calc}\left(\vec{H}\right) = \sum_{j=1}^{Nat} f_j occ_j \exp\left[2i\pi\vec{H}.\vec{r}_j\right] \exp\left[-2\pi^2\vec{H}^T.\vec{U}.\vec{H}\right]$$

modèle structural



Modèle structural



Utilité de la diffraction x monocristal



7. Exploitation Paramètres physiques + déviation standard



Symétrie Distances de liaison Angles de liaison Désordre Agitation thermique

à l'équilibre thermodynamique ou hors équilibre





Analyse structurale



- Distances de liaison
- Angles de liaison
- Angles de torsion
- Ellipsoïdes d'agitation thermique
- Contacts intermoléculaires





Relations structure-propriétés



Agitation thermique et facteur de Debye Waller

Approximation de Born-Hoppenheimer : la densité électronique suit le déplacement du noyau



$$\rho_{dynamique}(\vec{r}) = \int \rho_{statique}(\vec{r} - \vec{u}) p(\vec{u}) d\vec{u} = \rho_{statique}(\vec{u}) * p(\vec{u})$$

Fonction de densité de probabilité : $p(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi U}} \exp\left(\frac{-u^2}{2U}\right)$ dans l'approximation harmonique de symétrie sphérique

 $U = \langle u^2 \rangle$ est le déplacement quadratique moyen de l'atome par rapport à sa position d'équilibre

Agitation thermique et facteur de Debye Waller

$$\rho_{dynamique}(\vec{r}) = \int \rho_{statique}(\vec{r} - \vec{u}) p(\vec{u}) d\vec{u} = \rho_{statique}(\vec{u}) * p(\vec{u})$$

$$TF \qquad f(\vec{H}) = f_{statique}(\vec{H}) \cdot T(\vec{H})$$

Dans l'approximation harmonique isotrope :

$$T(\vec{H}) = \exp\left(-2\pi^2 U H^2\right) = \exp\left(-8\pi^2 U \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2}\right)$$
$$= \exp\left(-B \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2}\right) \qquad B \sim 3-10 \text{ Å}^2 (U \sim 0.02 - 0.12 \text{ Å}^2)$$

Agitation thermique et facteur de Debye Waller

$$\rho_{dynamique}(\vec{r}) = \int \rho_{statique}(\vec{r} - \vec{u})p(\vec{u})d\vec{u} = \rho_{statique}(\vec{u}) * p(\vec{u})$$

$$(U_{11} \quad U_{12} \quad U_{13})$$

$$U_{22} \quad U_{23}$$

$$U_{33})$$

Dans l'approximation harmonique isotrope :

$$T(\vec{H}) = \exp\left(-2\pi^2 U H^2\right) = \exp\left(-8\pi^2 U \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2}\right)$$
$$= \exp\left(-B \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2}\right) \qquad B \sim 3-10 \text{ Å}^2 (U \sim 0.02 - 0.12 \text{ Å}^2)$$

Dans l'approximation harmonique anisotrope :

$$T(\vec{H}) = \exp\left(-2\pi^2 \vec{H}^T \cdot \vec{U} \cdot \vec{H}\right) = \exp\left(-\sum_{i,j} 2\pi^2 h_i h_j a_i^* a_j^* (U_{ij})\right)$$

 \tilde{U} est le tenseur de déplacement atomique (symétrique)

Désordre structurale



Agitation thermique et désordre structural statique



Guionneau et al. J. Mater. Chem. (1999), 9, 985

Structures absolues

Loi de Friedel :
$$|F(hkl)| = |F(-h-k-l)|$$

En <u>l'absence de dispersion anomale</u>, le diagramme de diffraction est centrosymétrique : deux structures cristallines contenant deux énantiomères différents ne sont pas distinguables



En <u>présence de dispersion anomale</u> : Phénomène de résonnance (EXAFS, XANES)

$$f = f_0 + f'(E) + if''(E)$$





Structures absolues et activité optique

$$F^{2}(hkl,x) = (1-x)F(hkl)^{2} + xF(-h-k-l)^{2}$$

Paramètre de Flack : x

Application requière un atome lourd et choix approprié de la longueur d'onde λ



Groupe d'espace non centrosymétrique : Paramètre de Flack x P1 P1 0.012(1) 0.018(15)

Wang et al. Chem. Commun., (2009), 6940

Polymorphisme



Moliner *et al.*, (2001), *Inorg Chem*, **40**, 3986. Sheu *et al.*, (2008), *Inorg Chem*, **47**, 10866.

DRX monocristal combinée à DRX poudre

Diffraction x monocristal en fonction de T



displex





10K < T < 70K

300K < T < 1000K





Dilatation isobare





Matsuda et al. Phys. Rev B79, 172302 (2009) Margadonna et al., J. Am. Chem. Soc. 126, 15390 (2004) Kusz et al. *J Appl Cryst.*, **34**, 229, (2001)

Dilatation isobare



Kusz et al. J Appl Cryst., 34, 229, (2001)

Structure moyenne et structure locale



Brisure de symétrie : développement d'une surstructure



Brisure de symétrie : développement d'une surstructure



Brisure de symétrie : développement d'une surstructure



Bréfuel et al. Angew. Chem. (2009), 48, 9304

Photo-cristallographie: principe de la technique



Photo-chromisme

Dérivés de diaryléthène







Setup expérimental : mesure de laboratoire



Diffraction x monocristal sous pression







Diffraction x monocristal sous pression





P. Guionneau et al., Phys. Rev. (2005) B72, 214408

Références

• Géométrie de la diffraction, goniomètre 4 cercles, indexation

W. A. Paciorek, M. Meyer and G. Chapuis, (1999), Acta Cryst. A55, 543W. Kabsch, J. Appl. Cryst. (1988), 21, 67-71

• Intégration des données

W. Kabsch, J. Appl. Cryst. (1988), 21, 916-924
Z. Otwinowski & W. Minor, (1997), Methods in Enzymology, Vol. 276, pp. 307-326
A. G. W. Leslie, Acta Cryst. (1999), D55, 1696-1702
R. Diamond, (1969), Acta Cryst., A25, 43-55

• Remise à l'échelle W. Hamilton, J.S. Rollet, and R.A. Sparks (1965). *Acta Cryst.* **18**, 129-130

• Correction de TDS M. J. Cooper, K. D. Rouse, Acta Cryst. (1968), A24, 405

• Correction de polarisation

L. V. Azaroff, Acta Cryst. (1955), 8, 701-704 R. Kahn et al. J. Appl. Cryst. (1982), 15, 330

• Corrections d'absorption

Semi empirique

R.H. Blessing (1995). *Acta Cryst.* **A51**, 33-38 A. C. T. North, D. C. Phillips and F. S. Mathews (1968), Acta Cryst. A24, 351 N. Walker and D. Stuart (1983), Acta Cryst. A39, 158

Analytique et numérique

P. Coppens, L. Leiserowitz & D. Rabinovich, (1965), Acta Cryst., 1035-1038

Références

• Moyenne et traitement des réflexions discordantes

R.H. Blessing (1997). J. Appl. Cryst. 30, 421-426
R.H. Blessing and D.A. Langs (1987). J. Appl. Cryst. 20, 427-428

• Analyse de variance

R.H. Blessing (1987). *Crystallogr. Rev.* **1**, 3-58 R.H. Blessing (1989). *J. Appl. Cryst.* **22**, 396-397

• Normal probability plot

S. C. Abrahams & E. T. Keve (1971). Acta Cryst. A27, 157.

• Traitement bayésien des réflexions faibles

S. French and K. Wilson (1979). Acta Cryst. A34, 517-525.

• Méthodes directes

D. Harker & J. S. Kasper (1948), Acta Cryst. 1, 70
J. Karle & H. Hauptman (1950), Acta Cryst. 3, 181
H. Hauptman & J. Karle (1956), Acta Cryst. 9, 45
H. Hauptman & J. Karle (1959), Acta Cryst. 12, 93
D. Sayre (1952), Acta Cryst. 5, 60

• Résolution de structures par charge flipping

G. Oszlanyi & A. Süto, Acta Cryst (2008), A64, 123-134

- G. Oszlanyi & A. Süto, Acta Cryst (2004), A60, 134-141
- G. Oszlanyi & A. Süto, Acta Cryst (2005), A61, 147-152
- G. Oszlanyi & A. Süto, Acta Cryst (2007), A63, 156-163

présentation

sebastien.pillet@crm2.uhp-nancy.fr

Correction de Polarisation

$$I(\vec{H}) = \lambda^3 r_e^2 \left(\frac{V_{cristal}}{V_{maille}^2}\right) LPA(\vec{H}) \left[1 + \alpha(\vec{H})\right] F(\vec{H})^2$$

$$P = \frac{\left(\cos^2(2\theta_{mono})\cos^2(\rho) + \sin^2(\rho)\right)\cos^2(2\theta) + \cos(2\theta_{mono})\sin^2(\rho) + \cos^2(\rho)}{1 + \cos^2(2\theta_{mono})}$$

 θ_{mono} : angle de réflexion sur le cristal monochromateur

- θ : angle de diffraction de Bragg de la réflexion mesurée
- ρ : angle introduit par la projection sur une surface perpendiculaire au faisceau incident

parallèle : $\rho = 90^{\circ}$ perpendiculaire : $\rho = 0^{\circ}$ CCD : ρ

- Source conventionnelle (tube à rayons x, anode tournante) :
 - faisceau non polarisé (monochromatisé par un filtre)
 - polarisé après le cristal monochromateur (θ_{mono})
- Source synchrotron : faisceau polarisé linéairement dans le plan de l'orbite

$$P = P_0 - P' = \frac{1}{2} (1 + \cos^2 2\theta) - \frac{1}{2} \varsigma' \cos 2\rho \sin^2 2\theta$$

 $P = \frac{1 + \cos^2(2\vartheta)\cos^2(2\vartheta_{mono})}{1 + \cos^2(2\vartheta_{mono})}$

Méthodes de résolution de structure cristalline

Objectif : déterminer la distribution de densité électronique atomique dans la maille cristalline à partir des données de diffraction

$$\rho(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{h,k,l=-\infty}^{+\infty} F(\vec{H}) \exp\left[-2i\pi\vec{H}\cdot\vec{r}\right] \quad avec \quad F(\vec{H}) = \left|F(\vec{H})\right| \exp\left[i\varphi(\vec{H})\right]$$

Problème fondamental = perte de la phase

Il n'est pas possible de reconstruire la densité électronique d'une manière automatique et **unique**. Il est nécessaire de déterminer l'information manquante.

$$F(\vec{H}) = \sum_{j=1}^{Nat} f_j \exp[2i\pi \vec{H}.\vec{r}_j] \quad d'o\dot{u} \quad \left|F(\vec{H})\right|^2 = \sum_{j=1}^{Nat} f_j^2 + \sum_{j>k=1}^{Nat} f_j f_k \cos[2\pi \vec{H}.(\vec{r}_j - \vec{r}_k)]$$

Les intensités diffractées dépendent seulement des distances interatomiques.

Résoudre une structure = déterminer un set initial de $\{F_{initial}(\vec{H})|, \phi_{initial}(\vec{H})\}$
Méthodes directes : changement d'origine

$$F(\vec{H}) = \sum_{j=1}^{Nat} f_j \exp\left[2i\pi \vec{H}.\vec{r}_j\right] \qquad \vec{r}_j \to \vec{r}_j - \vec{r}_0$$

$$F'(\vec{H}) = \sum_{j=1}^{Nat} f_j \exp\left[2i\pi \vec{H}.(\vec{r}_j - \vec{r}_0)\right]$$

$$F'\left(\vec{H}\right) = \left|F\left(\vec{H}\right)\right| \exp\left[i\left(\varphi\left(\vec{H}\right) - 2\pi\vec{H}.\vec{r}_{0}\right)\right]$$

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{r}_0 \implies \varphi(\vec{H}) = \varphi(\vec{H}) - 2\pi \vec{H} \cdot \vec{r}_0$$

changement d'origine changement de phase



Fixer l'origine ou s'affranchir de l'origine

Algorithme moindres carrés non linéaire

$$\chi^{2} = \sum_{\vec{H}} \left[\frac{F_{obs} - F_{calc}(\{p_{j}\})}{\sigma(F_{obs})} \right]^{2} \qquad \min \chi^{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \chi^{2}}{\partial p_{j}} = -2 \sum_{\vec{H}} \frac{F_{obs} - F_{calc}}{\sigma^{2}(F_{obs})} \frac{\partial F_{calc}}{\partial p_{j}} = 0, \quad j = 1, 2, ..., m$$

Linéarise l'expression de F
$$F_{calc}(\{p\}) = F_{calc}(\{p_0\}) + \sum_{j} \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_j}\right) (p_j - p_{0,j})$$

$$\chi^{2} = \sum_{\vec{H}} \frac{1}{\sigma^{2}} \left[F_{obs} - F_{calc}(\{p_{0}\}) - \sum_{j} \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_{j}} \right) (p_{j} - p_{0,j}) \right]^{2}$$
$$\frac{\partial \chi^{2}}{\partial p_{k}} = -2 \sum_{\vec{H}} \frac{1}{\sigma^{2}} \left[F_{obs} - F_{calc}(\{p_{0}\}) - \sum_{j} \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_{j}} \right) \Delta p_{j} \right] \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_{k}} \right) = 0, \quad \Delta p_{j} = (p_{j} - p_{0,j})$$

$$\sum_{\vec{H}} \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j} \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_j} \right) \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_k} \right) \Delta p_j = \sum_{\vec{H}} \frac{1}{\sigma^2} \left[F_{obs} - F_{calc} \left(\{ p_0 \} \right) \right] \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_k} \right)$$

~ ~ ~

 $A\Delta p = B \implies \Delta p = A^{-1}B$

Algorithme moindres carrés non linéaire

$$\sum_{\bar{H}} \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j} \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_j} \right) \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_k} \right) \Delta p_j = \sum_{\bar{H}} \frac{1}{\sigma^2} \left[F_{obs} - F_{calc} \left(\{ p_0 \} \right) \right] \left(\frac{\partial F_{calc}}{\partial p_k} \right) \qquad A\Delta p = B \quad \Rightarrow \quad \Delta p = A^{-1} B$$

La matrice de variance-covariance pour les paramètres p_j ajustés par moindres carrés est l'inverse de la matrice normale A⁻¹ multiplié par le goodness of fit Z

$$Z^{2} = \frac{\chi^{2}}{N-m} \sum_{\bar{H}} \left[\frac{F_{obs} - F_{calc}(\{p_{j}\})}{\sigma(F_{obs})} \right]^{2}$$

$$\begin{pmatrix} \operatorname{var}(p_1) & \operatorname{cov}(p_1, p_2) & \cdots & \operatorname{cov}(p_1, p_m) \\ & \operatorname{var}(p_2) & \cdots & \operatorname{cov}(p_2, p_m) \\ & \ddots & \vdots \\ & & \operatorname{var}(p_m) \end{pmatrix} = Z^2 A^{-1}$$

 $\operatorname{cov}(p_i, p_j) = \rho_{ij}\sigma(p_i)\sigma(p_j)$ $\operatorname{var}(p_i) = \sigma^2(p_i)$

Rappels de probabilités et statistiques pour la réduction de données et l'analyse d'erreur

• Analyse de la tendance d'une distribution

- la valeur moyenne

Soit un échantillon de données redondantes mesurées *n* fois, $\{x_i, \sigma(x_i) | i = 1, 2, ..., n\}$

 $\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$ $\langle x \rangle = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i / \sum_{i=1}^{n} w_i$ moyenne pondérée

- la valeur médiane

Soit un échantillon rangé de données mesurées *n* fois, $\{x_1 < x_2 < ... < x_n\}$

$$x_{m\acute{e}diane} = \begin{cases} x_{(n+1)/2} & \text{si} & n = 2m + 1 \\ \frac{1}{2} [x_{n/2} + x_{(n/2)+1}] & \text{si} & n = 2m \end{cases}$$



Rappels de probabilités et statistiques pour la réduction de données et l'analyse d'erreur

• Analyse de la **dispersion** d'une distribution

- la variance de la distribution

$$\sigma_{\text{int}}^2(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2 \qquad \sigma_{\text{int}}^2(x) = \frac{n}{n-1} \sum_{i=1}^n w_i (x_i - \langle x \rangle)^2 / \sum_{i=1}^n w_i$$

- la déviation standard de la distribution (RMSD)

 $\sigma_{\rm int}(x) = \sqrt{\sigma_{\rm int}^2(x)}$

- la déviation standard sur la moyenne (si les données individuelles x_i sont des mesures indépendantes avec des erreurs non corrélées)

 $\sigma(\langle x \rangle) = \sigma_{\rm int}(x) / \sqrt{n}$

La distribution Gaussienne (normale)

Si on considère une variable x continue, la probabilité que x soit compris entre x et x+dx est donnée par

 $P(x) = \Phi(x) dx$

Où $\Phi(x)$ est la fonction de densité de probabilité de x

La fonction de densité de probabilité Gaussienne est donnée par

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \frac{-(x - \langle x \rangle)^2}{2\sigma^2}$$



La distribution Gaussienne (normale)



$I(hkl) \rightarrow |F(hkl)|$

Etant donné
$$\langle I(\vec{H}) \rangle$$
 et $\sigma(\langle I(\vec{H}) \rangle)$

$$|F(hkl)| = \sqrt{I_{corrigé}(hkl)}$$

$$\sigma^{2}(I) = \left(\frac{\partial I}{\partial F}\right)^{2} \sigma^{2}(|F|)$$

$$\sigma^2(I) = (2|F|)^2 \sigma^2(|F|)$$

$$\sigma(|F|) = \frac{1}{2|F|}\sigma(I)$$

Propagation des erreurs

Soit y une fonction de n variables $y = y(x_1,...,x_n)$

Un développement limité au premier ordre donne

$$dy = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right) dx_i \quad et \quad d^2 y = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial x_j} \right) dx_i dx_j$$

D'où en première approximation

$$\operatorname{var}(y) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial y}{\partial x_{i}} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial x_{j}} \right) \operatorname{cov}(x_{i}, x_{j}) \quad \operatorname{avec} \quad \begin{array}{c} \operatorname{cov}(x_{i}, x_{i}) = \sigma^{2}(x_{i}) = \left\langle \left[x_{i} - \left\langle x_{i} \right\rangle \right]^{2} \right\rangle \\ \operatorname{cov}(x_{i}, x_{j}) = \rho_{ij}\sigma(x_{i})\sigma(x_{j}) = \left\langle \left[x_{i} - \left\langle x_{i} \right\rangle \right] \left[x_{j} - \left\langle x_{j} \right\rangle \right] \right\rangle \end{array}$$

 ρ_{ij} est le coefficient de corrélation

Si $\rho_{ij}=0$, les deux variables x_i et x_j sont indépendantes

Si $\rho_{ij}\neq 0$, les deux variables x_i et x_j sont dépendantes l'une de l'autre

Propagation des erreurs

Si
$$\rho_{ij}=0$$
, $\forall i$, $\forall j$ alors $var(y) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^2 \sigma^2(x_i)$

Ex: $I(hkl) = I_{int}(hkl) - b \quad d'où \quad \sigma^2(I) = \sigma^2(I_{int}) + \sigma^2(b)$

 $I_{corr}(hkl) = \frac{I(hkl)}{LP}$ avec L et P toutes deux des fonctions de l'angle de diffraction ϑ

$$\sigma^{2}(I_{corr}) = I_{corr}^{2} \left[\frac{\sigma^{2}(I_{int}) + \sigma^{2}(b)}{(I_{int} - b)^{2}} + \frac{\sigma^{2}(L)}{L^{2}} + \frac{\sigma^{2}(P)}{P^{2}} + \frac{\sigma(L)\sigma(P)}{LP} \right]$$

Qualité du modèle structural



$$\delta R = \frac{F_{obs} - F_{calc}}{\sigma(F_{obs})}$$

$$R1 = \frac{\sum_{H} |F_{obs}| - |F_{calc}|}{\sum_{H} |F_{obs}|}$$

$$wR2 = \left(\frac{\sum_{H} w(F_{obs}^{2} - F_{calc}^{2})^{2}}{\sum_{H} w(F_{obs}^{2})^{2}}\right)^{1/2}$$

$$GoF = S = \left(\frac{1}{n-p}\sum_{H} w \left(F_{obs}^{2} - F_{calc}^{2}\right)^{2}\right)^{1/2}$$

Symétrie cristalline

Eléments de symétrie cristallographique : inversion, rotation, translation, rotoinversion, rototranslation, réflexion, réflexion-translation

Groupe ponctuel : groupe de symétrie qui laisse invariant un point du réseau : **32** L'ensemble des cristaux présentant le même groupe ponctuel appartiennent à la même **classe cristalline**

Principe de Neumann : les éléments de symétrie d'une propriété physique doivent inclure tous les éléments de symétrie du groupe ponctuel du cristal (la symétrie des propriétés physiques doit être au moins celle du groupe ponctuel du cristal)

La morphologie extérieure d'un cristal se conforme en général à sa symétrie ponctuelle





Groupes d'espace

Un groupe d'espace est un ensemble d'opérations de symétrie qui laissent invariant un cristal.

- **230 groupes d'espace** résultent de la combinaison des 32 groupes ponctuels avec les 14 réseaux de Bravais.
- En cristallographie, on les représente suivant la notation de Hermann-Maugin : C2/c



Symétrie cristalline

La présence des éléments de symétrie impose certaines restrictions sur la géométrie du réseau cristallin : **7 systèmes cristallins** dans lesquels on rassemble les groupes ponctuels





La maille élémentaire peut être **primitive** ou **non primitive**, selon qu'elle contient un ou plusieurs nœud du réseau



Symétrie cristalline

Il existe 14 réseaux d'espace basés sur des mailles primitives et non primitives que l'on appelle des réseaux de Bravais.



Désordre et diffusion diffuse

Le phénomène de diffusion diffuse est due à (1) la diffusion diffuse thermique liée aux déplacements atomiques corrélés (TDS) et (2) la diffusion liée au désordre cristallin

1) La diffusion diffuse thermique provient des vibrations de réseau (phonons)

2) La diffusion diffuse peut provenir d'un désordre de substitution ou de déplacement

$$F_{cristal}(\vec{H}) = \sum_{n_a} \sum_{n_b} \sum_{n_c} \sum_{j}^{maille} f_j e^{2i\pi \vec{H} \cdot \vec{r}_{jn}} = \sum_n F(\vec{H}) e^{2i\pi \vec{H} \cdot \vec{R}_n}$$

$$I(\vec{s}) \propto \left\langle \sum_{n,m} F_n e^{-2i\pi \vec{s} \cdot \vec{R}_n} F_{n+m}^* e^{2i\pi \vec{s} \cdot (\vec{R}_n + \vec{R}_m)} \right\rangle_t \propto \sum_m \left\langle F_n F_{n+m}^* \right\rangle_{n,t} e^{2i\pi \vec{s} \cdot \vec{R}_m}$$

$$\propto \left| \left\langle F_n(\vec{s}) \right\rangle_n \right|^2 \sum_{h,k,l} \delta(\vec{s} - \vec{H}_{h,k,l}) + \sum_m \left(\left\langle F_n F_{n+m}^* \right\rangle_n - \left| \left\langle F_n(\vec{s}) \right\rangle_n \right|^2 \right) e^{2i\pi \vec{s} \cdot \vec{R}_m}$$
Structure moyenne
Pics de Bragg
Désordre
Diffusion diffuse

Brisure de symétrie : développement d'une surstructure



Désordre et diffusion diffuse



Aspects cinétiques: état photo-stationnaire



La concentration à l'état photo-stationnaire d'espèces excitées est donnée par l'égalité entre le nombre de molécules activées et le nombre de molécules relaxant vers l'état fondamental

 $n_{stat.} = \frac{\kappa_1}{k_1 + k_2}$

$$n(t) = 1 - \frac{1 + n_{stat.} (\exp((k_1 + k_{-1})t) - 1)}{\exp((k_1 + k_{-1})t)}$$

Dilatation isobare

L'augmentation de température T d'un solide d'une quantité ΔT à pression constante induit une déformation de la maille cristalline qui peut être décrite à l'aide du tenseur de déformation :

$$\varepsilon_{ij} = \alpha_{ij} \Delta T$$

Les composantes du tenseur d'expansion thermique sont définies par :

$$\alpha_{ij} = \left(\frac{\partial \varepsilon_{ij}}{\partial T}\right)_p$$

L'expansion thermique volumique est donnée par la trace du tenseur :

$$\alpha_{V} = \left(\frac{1}{V}\right) \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right) = \sum_{i=1}^{3} \alpha_{ii} = tr(\alpha)$$

Dilatation isobare



Superconducteur ionique : argyrodite



7.

Superconducteur ionique : argyrodite



S. Albert et al., Acta Cryst. (2008) B64, 1.

7.

Méthodes directes : initialisation des phases

<u>Invariant de structure</u> : une combinaison de facteurs de structure dont la phase est invariante par changement d'origine étant donnée une structure et \forall le groupe d'espace

 $F(000) = \sum_{j=1}^{Nat} Z_j$ phase nulle et connue \forall la structure

 $F(\vec{H})F(-\vec{H}) = |F(\vec{H})|^2$ ne contient aucune information de phase

triplet de phase $F(-\vec{H})F(\vec{K})F(\vec{H}-\vec{K})$ avec la phase $\varphi(-\vec{H}) + \varphi(\vec{K}) + \varphi(\vec{H}-\vec{K})$ $\sum_{i} \vec{H}_{i} = 0$

<u>Semi-invariant de structure</u> : une combinaison de facteurs de structure dont la phase est invariante par changement d'origine conservant la symétrie ponctuelle de l'origine

dans des groupes d'espace de symétrie supérieure à P1, il existe plusieurs choix d'origine en des positions spéciales , par ex en P2 [(0 y 0), (1/2 y 0), (0 y 1/2), (1/2 y 1/2)]

 $F(\vec{H})F(\vec{L}) \qquad h_1 + h_2 + h_3 = 2n \qquad k_1 + k_2 + k_3 = 0 \qquad l_1 + l_2 + l_3 = 2n$

Absorption et agitation thermique (Rouse & Hewat)

Pour des cristaux faiblement absorbant, le facteur de transmission pour un cylindre ou une sphère peut être approximé par :

$$A = \exp\left[-\left\{a_{1}\mu R + a_{2}(\mu R)^{2}\right\} - \left\{b_{1}\mu R + b_{2}(\mu R)^{2}\right\}\sin^{2}\theta\right]$$

Que l'on peut factoriser en :

$$A = \exp\left[-\left\{a_{1}\mu R + a_{2}(\mu R)^{2}\right\}\right] \exp\left[-\lambda^{2}\left\{b_{1}\mu R + b_{2}(\mu R)^{2}\right\}\left(\frac{\sin\theta}{\lambda}\right)^{2}\right] = k\exp\left[-\Delta B\left(\frac{\sin\theta}{\lambda}\right)^{2}\right]$$

C'est-à-dire en un facteur d'échelle et un terme de Debye-Waller moyen.

